

第六届全国宽禁带半导体学术会议

会议通知（第一轮）

会议时间：2025 年 8 月 13 日-16 日

会议地点：中国·大连

主办单位：中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会
中国电子学会电子材料学分会

承办单位：大连理工大学
东北师范大学
第三代半导体产业技术创新战略联盟

协办单位：集成光电子全国重点实验室
宽禁带半导体超越照明材料与技术全国重点实验室
国家第三代半导体技术创新中心（苏州）

一、会议简介

近年来，宽禁带半导体已成为国际半导体及材料领域研究和发展的热点，已成为全球高技术竞争战略制高点之一。基于宽禁带半导体材料，半导体照明已经形成巨大规模的产业，并在电子功率器件、光电子器件等领域继续深入发展。为推动我国宽禁带半导体领域的发展，促进产学研交流与协同创新，中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会、中国电子学会电子材料学分会共同主办全国宽禁带半导体学术会议，会议每两年一届，至今已成功举办了五届，已发展成为我国宽禁带半导体领域的行业盛会。

2025 年，“全国宽禁带半导体学术会议”迎来了第六届，会议由大连理工大学、东北师范大学和第三代半导体产业技术创新战略联盟联合承办。届时，来自国内宽禁带半导体领域学术界、产业界的专家学者、科研技术人员、院校师生、企业家代表等，将围绕宽禁带半导体材料生长技术、材料结构与物性、光电子和电子器件研

发以及相关设备研发等领域开展广泛交流，促进产学研用的交流合作。这次会议必将对我国宽禁带半导体材料与器件的学术研究、技术进步、产业发展起到有力的推动作用。

二、组织机构

名誉主席：甘子钊、王占国、郑有炆

顾问委员会（按姓氏首字母排序）：

褚君浩、杜国同、顾 瑛、关白玉、郝 跃、黄 如、贾明星、江风益、李爱珍、李晋闽、李树深、刘纪美、刘 明、刘 胜、罗 毅、申德振、孙祥桢、王立军、许宁生、杨德仁、叶志镇、俞大鹏、张国义、张 荣、张 跃、郑婉华

大会主席：刘益春

共同主席：沈 波、杨 辉、吴 玲

程序委员会

主 席：徐 科

副主席：黎大兵、张源涛、朱嘉崎

委 员（按姓氏首字母排序）：

敖金平、蔡树军、陈 弘、陈 敬、陈堂胜、陈万军、陈小龙、程 凯、迟 楠、单崇新、丁琪超、董博宇、冯士维、冯志红、顾书林、贺东江、黄伯宁、黄 丰、康俊勇、赖占平、李国强、梁 建、刘 斌、刘建平、刘木清、刘 榕、刘新宇、刘 扬、龙世兵、陆 海、罗小蓉、马晓华、欧 欣、潘 毅、彭俊彪、皮孝东、邱宇峰、盛 况、孙 钱、孙伟锋、孙小卫、孙晓娟、唐 宁、万成安、万玉喜、汪 莱、王德君、王 钢、王宏兴、王建峰、王江波、王军喜、王 立、王新强、吴毅锋、肖国伟、徐海阳、徐士杰、徐现刚、许福军、薛玉雄、杨富华、叶建东、于洪宇、云 峰、张保平、张 波、张进成、张 龙、张乃千、张清纯、张玉明、赵德刚、赵丽霞、郑晨炎

组织委员会

主 席：梁红伟

副主席：陈志涛、阮军、张书明

委 员（按姓氏首字母排序）：

蔡端俊、曹峻松、陈敦军、陈 鹏、陈长清、陈秀芳、陈义强、
陈志忠、方 方、方文饶、房玉龙、和巍巍、黄少华、黄文海、
耿 博、龚 政、郭 清、郭世平、郭 炜、郝茂盛、胡卫国、
化梦媛、黄 凯、黄 森、何晨光、纪志坡、蒋 科、矫淑杰、
江 灏、鞠光旭、孔月蝉、李炳生、李金钗、李述体、李忠辉、
梁剑波、刘军林、刘可为、刘 雯、刘新科、刘玉怀、刘召军、
刘志强、刘宗亮、陆 敏、吕元杰、梅云辉、马剑刚、苗振林、
母风文、牛萍娟、潘尧波、裴 轶、齐红基、全知觉、任国强、
桑立雯、宋 波、孙海定、孙文红、孙永强、田朋飞、王光绪、
王嘉铭、王来利、王茂俊、王 琦、王荣华、王鑫华、王英民、
魏同波、汪炼成、吴 亮、吴嘉伟、吴雅萍、谢志国、徐明升、
闫建昌、杨 霏、杨兰芳、杨 树、杨学林、殷 红、于彤军、
张佰君、张 辉、张纪才、张建立、张景文、张苇杭、张 雄、
张宇昊、张紫辉、赵璐冰、赵 维、周春华、周 弘、周 琦

大会秘书处

秘 书 长： 张振中

副秘书长： 赵 红 张克雄 张赫之

成 员： 贾欣龙等

三、主要日程

日期	上午	下午
8 月 13 日（星期三）		注册报到
8 月 14 日（星期四）	开幕式及大会报告	分会报告
8 月 15 日（星期五）	分会报告	大会报告及闭幕式
8 月 16 日（星期六）	参观考察及返程	

四、大会主题

绿色能源与智能时代的宽禁带半导体技术

五、会议征文方向：

1. 材料生长(氮化物半导体、氧化物半导体、碳化硅、金刚石等)
2. 材料物性和表征技术(光、电、磁、热性质、缺陷物理等)
3. 光电子器件及其应用(LED、Micro-LED、LD、光电探测器等)
4. 电子器件及其应用(射频电子器件、功率电子器件、传感器及集成电路等)
5. 新型宽禁带材料与器件(超宽禁带半导体、二维宽禁带半导体、有机宽禁带半导体等)
6. 辐射及高能粒子探测器件

征文要求：

1. 符合上述内容的论文摘要；
2. 论文摘要主题突出、内容层次分明、数据准确、论述严谨、结论明确、采用法定计量单位；
3. 论文摘要须以 WORD 文档格式，包含标题、作者及其单位地址、正文、图表、参考文献等在内不超过一页 A4 纸；
4. 提交截止日前，以电子邮件方式（投稿邮箱：kxzhang@dlut.edu.cn、hez.zhang@dlut.edu.cn、

zhangzhenzhong@nenu.edu.cn) 提交至会议组委会秘书组; 相关模板可登录大会官网或查询附件;

5. 所有论文摘要均编入会议文集。

六、重要截止日期

1. 论文摘要提交截止日: 2025 年 4 月 30 日
2. 报告录用通知截止日: 2025 年 6 月 15 日
3. 注册费优惠截止日: 2025 年 7 月 10 日

七、论文征集联系人

张克雄: 15382208398; Email: kxzhang@dlut.edu.cn

张赫之: 13478911634; Email: hez.zhang@dlut.edu.cn

张振中: 18626668329; Email: zhangzhenzhong@nenu.edu.cn

热烈欢迎相关领域的专家、学者、行业企事业单位参会交流!

第六届全国宽禁带半导体学术会议组委会秘书处

(大连理工大学集成电路学院代章)

2025 年 3 月 17 日

